

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОБІЙ У ГРАТКАХ РЕЗИСТОРІВ ПРИ НАЯВНОСТІ РЕСИЛІНГУ

М. І. Лебовка^{1,2}, Р. М. Мельник², М. П. Купчик³, І. С. Гулий³

¹Національний університет “Киево-Могилянська академія”, кафедра фізико-математичних наук,
бул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04070, Україна

²Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України,
бульв. Вернадського, 42, Київ, 03142, Україна,

³Український державний університет харчових технологій,
бул. Володимирська, 68, Київ, 01033, Україна

(Отримано 29 грудня 2001 р.)

Вивчено процеси електричного пробою граток резисторів, що моделюють структуру неоднорідних систем при наявності обертості пробою резисторів (іх ресилінгу). Спостерігали періодичні зміни ступеня руйнування та провідності гратки, які залежали від співвідношення часу ресилінгу τ та величини зовнішньої напруги. Показано, що така поведінка характерна для чисто детерміністичної моделі електроруйнування при наявності ресилінгу й відображає просторово-часові зміни структури скрельованих перколоційних кластерів. Періодична поведінка може пригнічуватися при збільшенні зовнішньої напруги або наявності стохастичного внеску в закон руйнування опорів.

Ключові слова: електричний пробій, гратки резисторів, поріг протікання, перколоція по зв'язках.

PACS number(s): 64.60.Ak; 05.40+j

I. ВСТУП

Розуміння процесів, що визначають електричну стабільність гетерогенних матеріалів та композиційних систем, дуже важливе як з наукового, так і з технологічного поглядів. Ця ділянка досліджень досить широка і простягається від матеріалознавства, де вивчають дію сильних електричних полів на зміну структури та властивостей ізоляторів, керамічних матеріалів і тонких напівпровідникових плівок [1], до біологічних наук, де електричні поля застосовують для ефективного руйнування біологічних матеріалів, електроплазмолізу, інактивації мікробів і тонкого регулювання переносу біологічно активних елементів через мембрани всередину клітини [2,3]. Теоретичний опис процесів електричної нестабільності ускладнюється проявом низки малодосліджених механізмів пробою та провідності на мікрорівні, а також необхідністю враховувати макроструктури й перколоційні властивості гетерогенних матеріалів [4–6].

Останнім часом для вивчення природи електричної нестабільності складних гетерогенних систем широко використовують методи комп’ютерного моделювання. Тут одною з найліпше досліджених систем є сіточна модель випадкових резисторів (МВР), у якій значення провідностей резисторів задається випадковим чином. Для різних варіантів цієї моделі проведено детальний аналіз явищ перколоції й скейлінгу, функцій розподілу струму й напруги, а також процесів пробою [5,7–12]. Таку модель також використовували для вивчення електричної нестабільності тонких гетерогенних плівок та біологічних тканин [13–15].

Дуже цікавим є розгляд процесів електричної нестабільності для моделі МВР з оборотним пробоєм,

який відповідає умовам, коли руйнування, що викликане зовнішнім полем, може через певний час зникати або “заліковуватися”. Явища “заліковування”, або ресилінгу, добре відомі в матеріалознавстві [16], але їх також експериментально спостерігали при руйнуванні біологічних тканин в імпульсних електрических полях [3,15]. Постійна часу ресилінгу τ може залежати від напруженості зовнішнього поля E , часу його дії t , а також структури й типу матеріалу, що руйнується. На сьогодні ці залежності вивчені ще досить мало. Пояснення електрофізичної поведінки гетерогенного матеріалу, що руйнується під дією зовнішнього електричного поля, не тривіальне. Це зумовлено тим, що відгук макроскопічної провідності матеріалу на мікроскопічні зміни його властивостей може доволі складно залежати від структури й топології матеріалу.

У цій статті ми вивчаємо сіточну модель електропробою гетерогенного середовища при наявності ресилінгу його мікроскопічних елементів. Тут використано електрофізичну модель руйнування, що подібна до дослідженій раніше [8,15]. План подальшого викладу такий. У розділі II коротко описано комп’ютерну модель та наведено деталі чисельних розрахунків. У розділі III подано основні результати та їх обговорення. Стаття завершується короткими висновками в розділі IV.

II. МОДЕЛЬ

Ми розглядаємо двовимірну квадратну гратку провідностей розміром N^2 , що зорієнтована під кутом 45° щодо зовнішніх меж, між якими прикладена зовнішня напруга U (див. Рис. 1). Для цієї конфігурації гратки всі $N_{\text{tot}} = N \times N$ зв’язків є еквівалентними в

структурі гетерогенного середовища [10], і тут знімаються ефекти анізотропії пробою, викликані орієнтацією ґратки щодо прикладеного поля, яке спостерігали в [8, 13–15]. У напрямку x застосовували періодичні граничні умови. Випадковий розподіл провідностей генерували за домогою закону

$$G = 1 + dG(2\text{ran} - 1), \quad (1)$$

де dG — ступінь неоднорідності матеріялу, ran — випадкове число, що однорідно розподілене в інтервалі $(0, 1)$.

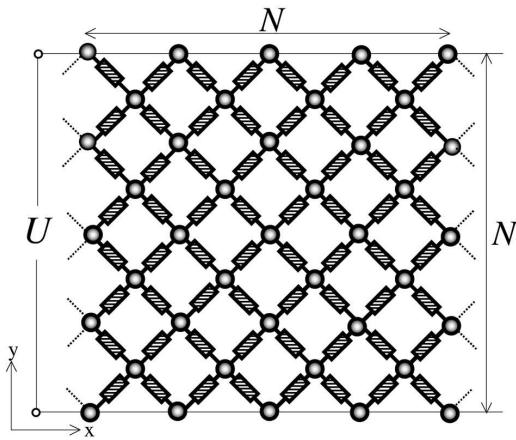


Рис. 1. Структура двовимірної квадратної ґратки провідностей розміром $N \times N$, $N = 8$, що використовувалась при моделюванні електричного пробою. Зовнішня напруга U прикладена між верхньою та нижньою паралельними лініями, в напрямку x застосовувались періодичні граничні умови.

У процедурі моделювання за домогою методу релаксації розв'язували рівняння Кірхгофа і знаходили потенціяли в усіх вузлах ґратки. Якщо різниця потенціалів Δu^n на певному опорі n перевищувала деяке критичне значення u_c , тобто

$$\Delta u \geq u_c, \quad (2)$$

цей опір руйнувався і його провідність G^n значно збільшувалась.

При руйнуванні ми робили заміну $G_i^n \rightarrow G_f^n$, де $G_f^n = \varepsilon G_i^n$, G_i^n є початковою провідністю n -го елемента, що руйнується, $\varepsilon \gg 1$ (в цій роботі ми завжди приймали $\varepsilon = 100$). Ця модель є узагальненням детерміністичної моделі пробою, яку запропонував Таякасу [7] для переходу провідник–надпровідник і наявності кінцевого часу ресилінгу.

Безрозмірну прикладену напругу визначали як

$$U^* = U/(Nu_c). \quad (3)$$

При цьому визначені для однорідного матеріялу

$(dG = 0)$ повне руйнування всіх опорів системи відбувається при $U^* = 1$.

Умовою зупинки процедури релаксації приймали відносну похибку обчислення потенціалів, меншу за 10^{-5} . Для встановлення впливу розміру системи на результати обчислень величину N змінювали в інтервалі $2^4 \div 2^{10}$. Попередні дослідження показали, що основні результати практично не залежать від розміру для $N \geq 256$, тому всі обчислення проводили для системи $N = 256 \times 256$ і дані усереднювали за 100 різними початковими конфігураціями.

Ресилінг провідностей зв'язків апроксимувався експоненційним законом

$$G(t) = (G_i + (G_f - G_i)) \exp(-t/\tau). \quad (4)$$

Тут час відповідає умовній одиниці, що пов'язана з часом руйнування одного зв'язку.

Загальний ступінь руйнування системи оцінювали як

$$P(t) = \frac{1}{N_{\text{tot}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{tot}}} \frac{G^n(t) - G_i^n(t)}{G_f^n(t) - G_i^n(t)}, \quad (5)$$

де сума береться по всім N_{tot} зв'язкам у системі.

Середню провідність системи G_m вираховували за допомогою модифікованого алгоритму Франка–Лобба [4, 17], а також оцінювали за допомогою формули [18]:

$$G_m = \sum_{n=1}^{N_{\text{tot}}} G^n \left(\frac{\Delta u^n}{U} \right)^2. \quad (6)$$

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ми раніше показали, що для детерміністичної моделі електропробою втрата електричної стабільності цих систем спостерігається тільки при наявності досить великої зовнішньої напруги, що перевищує деяке критичне значення U_{\min}^* [2, 8]. Це значення $U_{\min}^* = 1$ і зменшується зі збільшенням ступеня неоднорідності системи dG . Наприклад, для сильно неоднорідних систем при $dG = 0.90$ шляхом чисельних досліджень ми встановили, що $U_{\min}^* \approx 0.4$.

На рис. 2 показані типові часові залежності ступеня зруйнованості системи P і середньої провідності G_m для різних значень нормованої напруги U^* для часу ресилінгу $\tau = 10$. Повна електрична енергія системи пропорційна до середньої провідності G_m , і за відсутності ресилінгу вона має зростати, що відповідає зменшенню стабільності цієї системи [7].

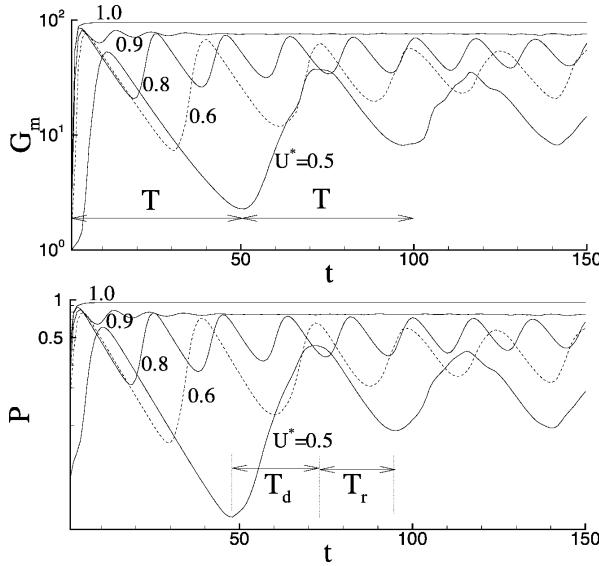


Рис. 2. Часові залежності ступеня руйнування системи P і середньої провідності G_m для різних значень нормованої напруги U^* . Розмір системи становив 256×256 , τ , $dG = 0.90$.

Для значень U^* , що трохи перевищують мінімальне значення U_{\min}^* і знаходяться в інтервалі $(0.5 \div 0.8)$, спостерігається гармонійно-подібна поведінка ступеня руйнування P і середньої провідності системи G_m . Початкове збільшення P і G_m через деякий час супроводжується їх експоненційним зменшенням (із часовою постійною рівною τ), потім подальшим збільшенням і так далі. У коливному режимі ступінь руйнування P змінюється між деякими границями значеннями від P_{\min} до P_{\max} , що залежать від U^* . Период коливань T складається з часу руйнування T_d і часу ресилінгу $T_r \approx \tau \ln P_{\max}/P_{\min}$ (див. рис. 2), і він збільшується при збільшенні τ як $T \propto \tau$. Зі збільшенням зовнішньої напруги U^* період T зменшується (рис. 3), при $U^* > 0.8$ спостерігаються майже згасні коливання, а при $U^* \geq 0.95$ відбувається сильне загасання, процес стає аперіодичним і спостерігається повне пригнічення ресилінгу.

Можливість прояву коливальної поведінки для детерміністичної моделі електроруйнування при наявності миттєвого оборотного відгуку провідності була відзначена ще в праці Такаясу [7], однак для такої моделі не спостерігається переколяційної поведінки.

Типові приклади часової еволюції картин електроруйнування для системи розміром 64×64 при напрузі $U^* = 0.5$ і $\tau = 10$ показані на рис. 4. Бачимо, що періодичність зміни ступеня зруйнованості системи P відповідає просторово-часовим періодичним змінам характеру руйнування гратки.

При невеликих напругах ($U^* < 0.5 \div 0.7$) спостерігається просторово-скорельована руйнація пробою, тому що вірогідність пробою в околі кластерів зруйнованих елементів є значно вищою, ніж на великих відстанях від них.

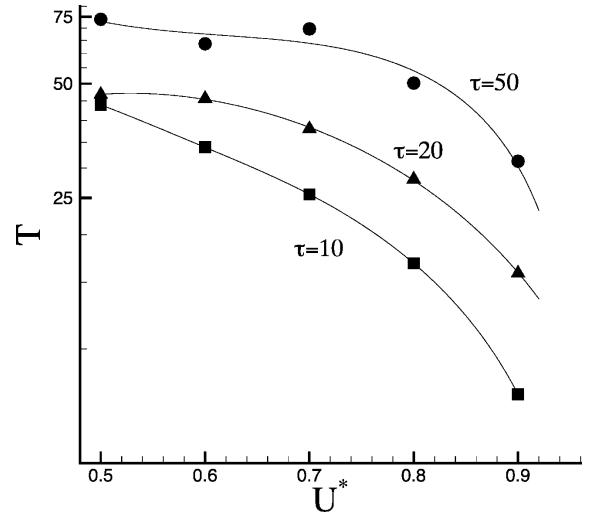


Рис. 3. Залежність періоду коливань T від нормованої зовнішньої напруги U^* для різних значень τ . Розмір системи становив 256×256 , $dG = 0.90$.

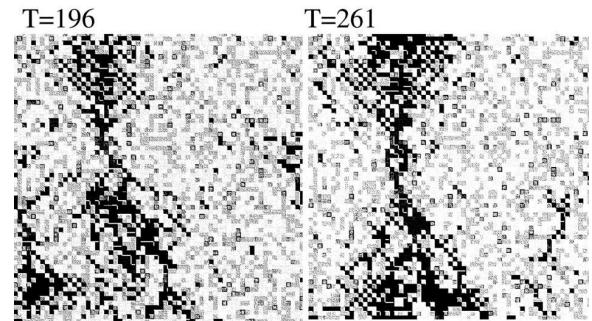


Рис. 4. Часова еволюція картин електроруйнування для системи розміром 64×64 при $U^* = 0.5$ і $\tau = 10$.

У переколяційній точці кластери пробою мають анізотропну форму, вони витягнуті вздовж поля, і ця переколяція значно відрізняється від переколяції випадкового типу. При електричному пробою можна спостерігати переколяцію скорельованого типу, що контролюється умовами руйнування, визначеними прикладенням зовнішнього поля [8,13–15]. Після виникнення переколяційного кластера — лідера для всіх елементів, що входять до його складу, утворюються сприятливі умови для заликовування, тому що градієнти потенціалів на елементах усередині пробоюного кластера є відносно малими. У цій фазі відбувається переважно тільки ресилінг і опори всередині переколяційного кластера майже не руйнуються. Із досягненням деякої критичної міри заликовування в цьому кластері відворюються умови можливості руйнування.

При наявності гармонійної динаміки процесів руйнування–відновлення в системі домінують процеси, що приводять до виникнення в системі одного або декількох кластерів пробою, які періодично ви-

никають і заліковуються приблизно в одних і тих же самих просторових ділянках.

Зі збільшенням зовнішньої напруги до досить великих значень ($U^* > 0.85$) у неоднорідній системі можливе одночасне виникнення багатьох центрів росту нових кластерів і ступінь неоднорідності системи зростає. Просторово-часова повторюваність картин руйнування згодом втрачається і спостерігається повне пригнічення коливного характеру $P(t)$ і $G_m(t)$. У стаціонарному стані встановлюється рівноважний стан і спостерігаються постійні процеси руйнування опорів у випадкових просторових точках системи та їх поступове відновлення. При цьому структура переколяційних кластерів подібна до структури кластерів у задачі випадкової переколяції.

Для детерміністичної моделі пробою особливу роль у наявності коливальної поведінки може відігравати ступінчастий закон руйнування елементів (2) і початковий просторовий розподіл провідностей G по гратці. Для перевірки цього припущення ми розглянули також загальніший закон руйнування елементів гратки, у якому припускалося, що ймовірність руйнування f лінійно залежить від напруги за законом $f = 0.5 + (\Delta u/u_c - 1)/\alpha$ при $|\Delta u/u_c - 1| \leq \alpha$, $f = 0$ при $\Delta u/u_c < 1 - \alpha$ і $f = 1$ при $\Delta u/u_c > 1 + \alpha$. Тут параметр α характеризує ширину функції розподілу вірогідностей напруги руйнування, і при $\alpha = 0$ цей закон переходить у ступінчастий закон (2). Такий закон дозволяє зробити певний імовірнісний внесок у детерміністичну модель електроруйнування. На рис. 5 показані типові часові залежності ступеня зруйнованості системи P для різних значень $\alpha = 0$ при $U^* = 0.5$, $\tau = 10$, $dG = 0.90$ і системи розміром 256×256 . Ми бачимо, що зі збільшенням α коливний характер часових змін P пригнічується, і при $\alpha > 0.5$ він практично зникає, тобто зі збільшенням стохастичного внеску в детерміністичну модель коливальна поведінка, що зумовлена ресилінгом, починає нівелюватися.

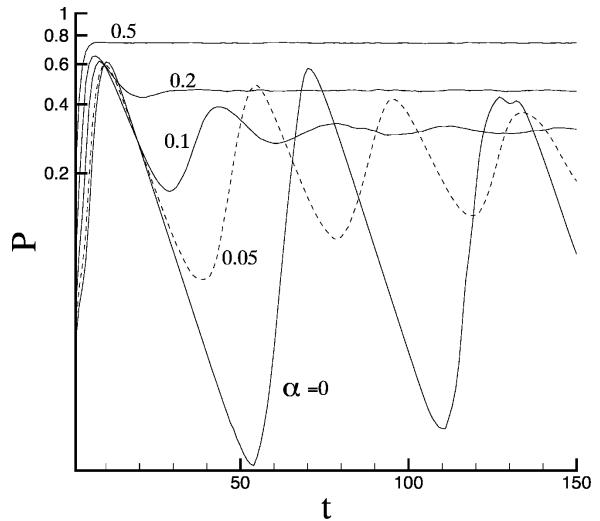


Рис. 5. Часові залежності ступеня руйнування системи P при різних значеннях α . Розмір системи складав 256×256 , $\tau = 10$, $dG = 0.90$.

IV. ВИСНОВКИ

Таким чином, при наявності ресилінгу зв'язків в електропробої в неоднорідних системах можуть спостерігатися коливні зміни ступеня руйнування й середньої провідності з періодом, що пропорційний часу ресилінгу τ . Гармонійна поведінка характерна для чисто детерміністичної моделі електроруйнування. Вона відображає просторово-часові зміни структури скорельзованих переколяційних кластерів і може пригнічуватися зі збільшенням зовнішньої напруги або наявності стохастичного внеску в закон руйнування опорів.

-
- [1] M. Ohring, *Reliability and Failure of Electronic Materials and Devices*(Academic, New York, 1998).
 - [2] I. S. Gulyi, N. I. Lebovka, V. V. Mank, M. P. Kupchik, M. I. Bazhal, A. B. Matvienko, A. Y. Papchenko, *Scientific and practical principles of electrical treatment of food products and materials*, (Kiev: UkrINTEI, 1994).
 - [3] D. Knorr, Current Opinion in Biotechnology **10**, 5, 485 (1999).
 - [4] D. Stauffer, A. Aharony, *Introduction to Percolation Theory* (Taylor and Francis, London, 1992).
 - [5] M. Sahimi, Phys. Rep. **306**, 213 (1999).
 - [6] V. I. Roldugin, V. V. Vysotskii, Progress in Organic Coating **39**, 81 (2000).
 - [7] H. Takayasu, Phys. Rev. Lett. **54**, 11, 1099 (1985).
 - [8] N. I. Lebovka, V. V. Mank, Physica A **181**, 346 (1992).
 - [9] R. F. Angulo, E. Medina, Physica A **191**, 410 (1992); e-print cond-mat/9405010.
 - [10] D. Sornette, C. Vanneste, Phys. Rev. E **50**, 4327 (1994).
 - [11] G. G. Batrouni, A. Hansen, B. Larson, Phys. Rev. E **53**, 2292 (1995); e-print cond-mat/9508041.
 - [12] P. M. Duxbury P. D. Beale, C. Moukarzel, Phys. Rev. B **51**, 3476 (1995).
 - [13] C. Pennetta, L. Reggiani, L. B. Kiss, Physica A **266**, 214 (1999).
 - [14] C. Pennetta, L. Reggiani, Gy. Trefan, Physica A **266**, 214 (1999).
 - [15] N. I. Lebovka, M. I. Bazhal, E. I. Vorobiev, Innovative Food Science & Emerging Technologies, **2**, 111 (2001); e-print cond-mat/0005252.
 - [16] Я. У. Гегузин, *Почему и как исчезает пустота* (Наука, Москва, 1983).
 - [17] J. Hoshen, R. Kopelman, Phys. Rev. B **14** 3438 (1976).
 - [18] R. Rammal, C. Tannous, P. Breton, A. M. S. Tremblay, Phys. Rev. A **31**, 2662 (1985).

**ELECTRICAL BREAKDOWN IN RESISTOR NETWORKS
WITH THE EXISTENCE OF RESEALING**

N. I. Lebovka^{1,2}, R. M. Melnyk², M. P. Kupchik³, I. S. Gulyi³

¹*National University of "Kiev Mogyla Academy", Physics and Mathematics Department,*

²*G. Scovoroda Str., Kyiv, UA-04070, Ukraine*

²*Biocolloidal Chemistry Institute named after F. D. Ovcharenko NAS of Ukraine,*

^{42 bulv. Verdanskogo, Kyiv, UA-03042, Ukraine,}

³*Ukrainian State University of Food Technology, 68 Volodymyrska Str., Kyiv, UA-01033, Ukraine*

e-mail: lebovka@roller.ukma.kiev.ua, Nikolai.Lebovka@utc.fr

The electrical breakdown processes in heterogeneous resistor networks were studied for the case of the time-reversible damage or sealing of resistors. The periodical changes in a damage degree and a total conductivity of a lattice were observed that depend on sealing time constant τ and value of external voltage. The periodical behaviour is characteristic for a pure deterministic breakdown model with sealing and reflect temporally-dimensional changes in the structure of correlated clusters of breakdown resistors. This behaviour can be suppressed at increasing external voltage or when the stochastic factor in a damage law is present.